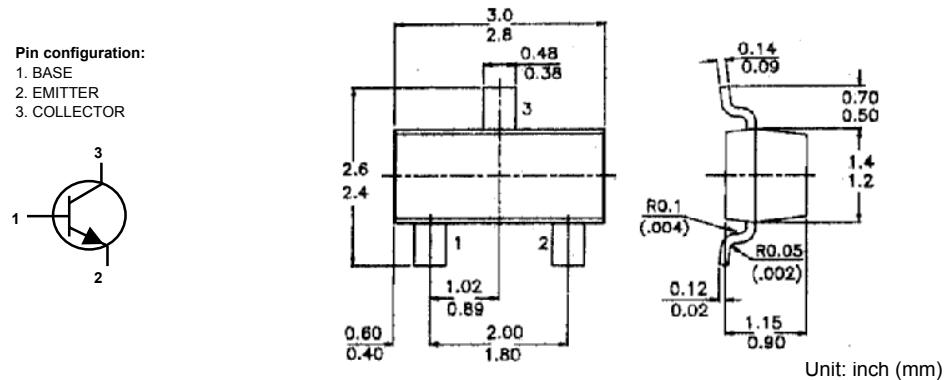


NPN Silicon Planar Epitaxial Transistors



SOT-23 SMD Package

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$ unless specified otherwise)

DESCRIPTION	SYMBOL	BC846	BC847	BC848	UNITS
Collector Base Voltage	V_{CBO}	80	50	30	V
Collector Emitter Voltage ($V_{BE} = 0\text{V}$)	V_{CES}	80	50	30	V
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	65	45	30	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	6	6	5	V
Collector Current (DC)	I_C		100		mA
Collector Current - Peak	I_{CM}		200		mA
Emitter Current - Peak	$-I_{EM}$		200		mA
Base Current - Peak	I_{BM}		200		mA
Total power dissipation up to $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}^{**}		250		mW
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150		°C
Junction Temperature	T_j		150		°C

Thermal Resistance

From junction to ambient	$R_{th(j-a)}^{**}$	500	K/W
--------------------------	--------------------	-----	-----

**Mounted on a ceramic substrate of 8mm x 10mm x 0.7mm

Electrical Characteristics (at $T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS
Collector Cut Off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0$ $V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0, T_j = 150^{\circ}\text{C}$		15	nA	
				4	uA	
Base Emitter On Voltage	$V_{BE(on)}^*$	$I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$	0.58	0.7	0.77	V
Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$ $I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$		0.25	0.60	V
Base Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(Sat)}^{***}$	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$ $I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$		0.7	0.9	V
DC Current Gain	h_{FE}	$I_C = 10\text{uA}, V_{CE} = 5\text{V}$ BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C $I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ BC846 BC847/BC848 BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C		90	150	
				270		
				110	450	
				110	800	
Collector Capacitance	C_C	$I_E = i_e = 0, V_{CB} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2.5		pF
Transition Frequency	f_T	$I_C = 10\text{mA}, V_{CB} = 5\text{V}, f = 100\text{MHz}$	100			MHz
Small Signal Current Gain	$ h_{fe} $	$I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}, f = 1\text{kHz}$ BC856 BC857/BC858 BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C		125	500	
				125	900	
				125	260	
				240	500	
				450	900	
Noise Figure	NF	$I_C = 0.2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $R_S = 2\text{k ohm}, f = 1\text{kHz}, B = 200\text{Hz}$		10		dB

* $V_{BE(on)}$ decreases by about 2mV/K with increase temperature.

*** $V_{BE(Sat)}$ decreases by about 1.7mV/K with increase temperature.

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9